

## บทที่ 5 อภิปรายและสรุปผล

การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี สเป็ตเตอริงที่เคลือบบนชิลิกอน เวเฟอร์ และกระจากสไลด์ เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มที่เคลือบได้ภายใต้ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ อัตราส่วนของเกลือสาร์กอนต่อเกลือออกซิเจน เวลาที่ใช้ในการเคลือบ และอุณหภูมิอ่อนน้อม ผลลัพธ์นี้

### อภิปราย

#### 1. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์

เงื่อนไขสำคัญสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ คืออัตราส่วนของเกลือสาร์กอนต่อเกลือออกซิเจน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะทำการกำหนดให้อัตราการไหลของเกลือสาร์กอนเป็น 1 sccm และทำการเปลี่ยนอัตราการไหลของเกลือออกซิเจนเป็น 2, 4 และ 8 sccm โดยทำการเคลือบฟิล์มด้วยกำลังไฟฟ้า 120 watt เป็นเวลา 180 min ที่อุณหภูมิห้อง จากการทดลองพบว่าเมื่อใช้อัตราส่วนเกลือสาร์กอนต่อเกลือออกซิเจนเท่ากัน 1: 4 เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ เนื่องจากอัตราส่วนนี้สามารถสร้างโกล์วิติสchar์จได้ แล้วเกิดฟิล์มบางบนวัสดุรองรับที่มีลักษณะใส รวมถึงสามารถอ่านค่าความดันรวมได้

เมื่อนำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่า ฟิล์มบางที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องมีโครงสร้างผลึกแบบสัมฐาน แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นผลึกเนื้องจากรูปแบบการเลี้ยงเม็ดรังสีออกซิเจน แต่เมื่อยังคงอุณหภูมิที่ 500 °C นาน 1 ชั่วโมง แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD อีกครั้งพบว่าฟิล์มบางแสดงความเป็นผลึกของไททาเนียมโดยออกไซด์เฟส్ట్รุ่่ไทยล์ ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลการทดลองที่ได้ จึงนำฟิล์มที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 500 °C นาน 1 ชั่วโมง แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD อีกครั้งพบว่าฟิล์มบาง Tavares et al. (2007) ที่เคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี สเป็ตเตอริง แล้วได้ฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบสัมฐาน แต่เมื่อนำฟิล์มไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบร่วมกับฟิล์มที่ทดลองจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเฟสอนาคตและรู่ไทยล์ ตามลำดับ แต่ถึงที่สอดคล้องกันคือเมื่อทำการอบอ่อนฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์จะทำให้ฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์มีความเป็นผลึกสูงขึ้น

#### 2. การหาอัตราเคลือบของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์

ในการทดลองเพื่อหาอัตราเคลือบของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์นี้กำหนดให้อัตราส่วนของเกลือสาร์กอนต่อเกลือออกซิเจนเท่ากัน 1: 4 sccm ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ

การเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ของงานวิจัยนี้ ทำการเคลือบฟิล์มนิลิกอนเวเฟอร์โดยใช้กำลังไฟฟ้า 200 watt เป็นเวลา 60, 120, 240, 360 และ 480 min ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้ไปวัดความหนาด้วยเทคนิค AFM

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อใช้เวลาในการเคลือบเพิ่มมากขึ้นฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่ได้ จะมีความหนาเพิ่มขึ้น เมื่อนำมาค่าความหนาของฟิล์มกับเวลาที่ใช้ในการเคลือบมาเขียนกราฟความสัมพันธ์พบว่า ความหนาของฟิล์มและเวลาที่ใช้ในการเคลือบมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้น ทั้งนี้จากการฟีดบาร์ดหาอัตราเคลือบที่เรื่อง ไขดังกล่าวได้ ซึ่งอัตราเคลือบสำหรับการทดลองนี้ค่าเท่ากับ  $0.74 \text{ nm/min}$

3. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ สิ่งที่มีผลต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ นอกจำกอัตราส่วนของแก๊สอะร์กอนและแก๊สออกซิเจนแล้ว การให้ความร้อนแก่ฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ภายหลังการเคลือบก็ส่งผลอย่างมากต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์ม การทดลองนี้กำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอะร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 1: 4 sccm ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ของงานวิจัยนี้ ทำการเคลือบฟิล์มนิลิกอนเวเฟอร์โดยใช้กำลังไฟฟ้า 200 watt เป็นเวลา 360 min ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ  $500^{\circ}\text{C}$  จากนั้นนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์

จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องมีรูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ที่ไม่แสดงพีกที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นโคลน แต่มีการทำกรอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ  $500^{\circ}\text{C}$  พบว่ารูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์แสดงความเป็นพีกที่เด่นชัดขึ้น แสดงว่าโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์มีการจัดเรียงตัวของผลึกคืบขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ben Amor et al. (2002) ได้กล่าวถึงผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ไว้ว่าฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์เมื่อผ่านการทำให้ฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์มีการจัดเรียงตัวของผลึกคืบขึ้น

4. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ นอกจำกัดการทำกรอบอ่อนฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์จะส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของผลึกแล้ว ยังส่งผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์อีกด้วย จากการศึกษางานวิจัยของ Li et al. (2000) พบว่า ฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ที่ผ่านการทำกรอบอ่อน ขนาดของกรานนีขนาดใหญ่เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนสูงขึ้น

ในการทดลองนี้กำหนดให้อัตราส่วนของแก๊สอะร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 1: 4 sccm ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ของงานวิจัยนี้

ทำการเคลือบบนชิลิกอนเวฟออร์โดยใช้กำลังไฟฟ้า 200 watt เป็นเวลา 360 min ที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ 500 °C และนำไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเทคนิค AFM เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์

จากการทดลองพบว่าเกรนมีขนาดเล็กลงเมื่ออบอ่อนฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ที่อุณหภูมิ 100 °C ถึงอุณหภูมิ 300 °C และขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบอ่อนเพิ่มเป็น 400 และ 500 °C ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยของ Hou et al. (2003) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องผลของอุณหภูมิ การอบอ่อนที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ และอธิบายผลไว้ว่า เมื่ออุณหภูมิ การอบอ่อนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากเกรนที่มีขนาดเล็กเมื่อได้รับพลังงาน จะทำให้เกรนขนาดเล็กเกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกัน ทำให้ขนาดของเกรนใหญ่ขึ้น

ส่วนความรุحرของฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์เมื่อทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า เมื่อทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100 °C ถึงอุณหภูมิ 300 °C ความรุحرมีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มเป็น 400 และ 500 °C ซึ่งคุณภาพสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเกรนกับ ความรุحرพบว่าเมื่อขนาดของเกรนเล็กลงทำให้ความรุحرเพิ่มขึ้น และถ้าขนาดของเกรนใหญ่ขึ้นจะทำให้ความรุحرลดลง

5. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ นอกจากอุณหภูมิอบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวแล้ว อุณหภูมิ อบอ่อนยังส่งผลต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่บอกร่องการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแสงคือค่าคงที่ทางแสง ได้แก่ ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญ

การทดลองนี้กำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 1: 4 sccm ซึ่ง เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ของงานวิจัยนี้ จากนั้น เคลือบฟิล์มน้ำกระเจาโดยใช้กำลังไฟฟ้า 200 watt เป็นเวลา 360 min ที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ 500 °C และนำไปวัดค่าเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสง ซึ่งเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงนี้สามารถนำไปหาค่าดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญได้ ด้วยวิธี Envelope

จากการทดลองพบว่า ฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องมีลักษณะ ใสในช่วงอัตราไฟโอลูเตทจะมีเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงต่ำ (น้อยกว่า 1%) และมีค่าเบอร์เซ็นต์ การส่งผ่านแสงมากขึ้นในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วง ที่ตามองเห็นเท่ากับ 76.09 % เมื่อนำฟิล์มบางไทยาเนียมได้ออกไซด์ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ ฟิล์มบางยังคงให้เบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นอัตราไฟโอลูเตตต่ำเหมือนกับ

ฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์ที่ไม่ได้ผ่านการอบอ่อน แต่เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ต้านองเห็นมีค่าสูงขึ้น ส่วนค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าลดลง ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงยังคงมีค่ามากกว่า 70%

เมื่อนำเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมาคำนวณด้วยวิธี Envelope พบว่า ดัชนีหักเหมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น ส่วนสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hou et al. (2003) ที่กล่าวว่าดัชนีหักเหจะมีค่าเพิ่มขึ้นและสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น

## สรุปผล

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์ที่เตรียมด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี สਪิตเตอริง โดยเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์บนซิลิกอนเควเฟอร์และกระจกสไลด์ ภายใต้เงื่อนไขการเคลือบต่าง ๆ รวมถึงการอบอ่อนฟิล์มเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว และสมบัติทางแสงด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลโดยแสดงเป็นหัวข้อดังนี้

### 1. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์

จากการทดลองการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์พบว่า อัตราส่วนของเก็สอาร์กอนต่อเก็สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์คือท่อัตราส่วน 1:4 sccm เนื่องจากที่อัตราส่วนนี้สามารถสร้างໂලດ์ดิสหาร์จได้ เกิดฟิล์มบางวนวัสดุรองรับที่มีลักษณะใส รวมถึงสามารถอ่านค่าความดันรวมได้ เมื่อนำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบว่า ฟิล์มบางที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องมีโครงสร้างผลึกแบบสัมฐาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมได้นำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{C}$  พบว่า ฟิล์มบางแสดงความเป็นผลึกของไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์เฟสруู่ล์ ระหว่าง (110), (101), (111) และ (211) อย่างชัดเจน

### 2. การหาอัตราเคลือบของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์

จากการทดลองการหาอัตราเคลือบของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์ พบว่า เมื่อเวลาที่ใช้เคลือบเพิ่มขึ้นความหนาฟิล์มบางจะเพิ่มขึ้น เมื่อนำผลที่ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิล์มกับเวลาในการเคลือบซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถหาอัตราเคลือบได้เท่ากับ  $0.74 \text{ nm/min}$

### 3. ผลกระทบของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์ พบว่า ฟิล์มบางไททาเนียมไ/do/ok/ไซด์ที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ มีรูปแบบ

การเลือกใช้วัสดุรังสีเอกซ์ที่แสดงความเป็นพิคได้เด่นชัด โดยพิคที่พบคือพิคที่มุม 27.5, 36.1, 41.3 และ 54.4 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับพิคมาตรฐาน JCPDS พบว่า เป็นมุมของพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ฟลูอิเดรานา (110), (101), (111) และ (211) ตามลำดับ

4. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ จากการศึกษาผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ พบร่วมกับลักษณะของเกรนเม็ดขนาดเล็กลงเมื่ออ่อนอ่อนพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ ที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{C}$  ถึงอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  และเม็ดขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบอ่อนเพิ่มเป็น  $400^{\circ}\text{C}$  และ  $500^{\circ}\text{C}$  ส่วนความชุกราของพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์เมื่อทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ พบร่วมกับเมื่อทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{C}$  ถึงอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ความชุกรามีค่าเพิ่มขึ้น และ มีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มเป็น  $400^{\circ}\text{C}$  และ  $500^{\circ}\text{C}$

5. ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อสมบัติทางแสงของพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ พิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ที่เคลือบได้มีลักษณะใส ส่องผ่านแสงดีในช่วงตามองเห็น โดยมีค่าเฉลี่ยปอร์เซนต์การส่องผ่านแสงในช่วงที่ตามองเห็นเท่ากับ 76.09 %. เมื่อนำพิล์มนบาง ไทยเนียม ไอออกไซด์ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบร่วมกับค่าดัชนีหักเหของพิล์มจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น ส่วนสัมประสิทธิ์การดับสูญเสียค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น